

平成 27 年度第 4 回半導体エレクトロニクス部門委員会
第 1 回講演会・見学会 講演プログラム

主 催： 日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会

期 日： 平成 28 年 1 月 30 日（土）

会 場： 福井大学文京キャンパス 工学部総合研究棟 13 階大会議室

〒910-8507 福井市文京 3 丁目 9-1

〈アクセス http://www.u-fukui.ac.jp/cont_about/outline/access.html〉

〈基調講演〉 13:00-13:40

「テラヘルツ時間領域分光法とその応用」

谷 正彦 教授（福井大学 遠赤外領域開発研究センター長）

〈招待講演〉

(I-1) 13:40-14:05

「顕微光応答法による金属/半導体界面の 2 次元評価」

塩島 謙次 准教授（福井大学 工学研究科）

(I-2) 14:05-14:30

「ポリシルセスキオキサンの有機薄膜トランジスタ用ゲート絶縁膜への応用」

田中 一郎 教授（和歌山大学 システム工学部）

〈ポスターセッション〉 14:40-16:15

(P1) 自立 n-GaN 基板の劈開面に形成したショットキー電極の評価◇

永縄 萌⁽¹⁾, 青木 俊周⁽¹⁾, 三島 友義⁽²⁾, 塩島 謙次⁽¹⁾

⁽¹⁾福井大院工, ⁽²⁾法政大

(P2) 電圧ストレスにより劣化した n-GaN ショットキー接触の 2 次元評価◇

村瀬 真悟⁽¹⁾, 太田 博⁽²⁾, 三島 友義⁽²⁾, 塩島 謙次⁽¹⁾

⁽¹⁾福井大院工, ⁽²⁾法政大

(P3) Eu 添加 GaN における Eu イオンの価数制御◇

布川 拓未, 小泉 淳, 松田 将明, 朱 婉新, 藤原 康文

大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻

(P4) 二波長励起測定法を用いた Eu 添加 GaN のエネルギー輸送プロセスの動的評価◇

小亀 宏朗, 岡田 浩平, 児島 貴徳, 小泉 淳, 藤原 康文

大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻

(P5) Si/6H-SiC 貼り合わせ界面欠陥層を介する漏れ電流伝導機構の解析◇

袖岡 大輝⁽¹⁾, 木下 博之⁽¹⁾, 石田 秀俊⁽²⁾, 吉本 昌広^(1,2)

⁽¹⁾京都工芸繊維大学電子システム工学専攻, ⁽²⁾京都工芸繊維大学グリーンイノベーションセンター

(P6) 界面顕微光応答法による Si/SiC ヘテロ接合の 2 次元評価◇

新郷 正人⁽¹⁾, Liang Jianbo⁽²⁾, 重川 直輝⁽²⁾, 塩島 謙次⁽¹⁾

福井大院工, ⁽²⁾大阪市大院工

(P7) Er, O 共添加 GaAs フォトニック結晶点欠陥共振器レーザーの実現に向けて—数値解析—◇

小川 雅之, 児島 貴徳, 櫻木 寛至, 藤岡 夏輝, 小泉 淳, 藤原 康文

大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻

(P8) レーザ発振を示す半金属半導体混晶 GaAs_{1-x}Bi_x の発光特性◇

来馬 英樹, 冬木 琢真, 吉岡 諒, 芝田 悠将, 西中 浩之, 吉本 昌広

京都工芸繊維大学電子システム工学専攻

(P9) ベンゾジチオフェン系薄膜の成膜性改善と有機薄膜トランジスタの作製◇

山下 真由子, 福村 光平, 前田 恵, 後藤 扶美子, 大須賀 秀次, 宇野 和行, 田中 一郎

和歌山大学システム工学部

- (P10) 正圧電応答を利用した新しい強誘電性ドメインの観察評価手法の提案◇
 荻谷 健人, 吉村 武, 藤村 紀文
 大阪府立大学
- (P11) コランダム構造酸化インジウム薄膜の構造・電気特性◇
 北島 雅士, 内田 貴之, 金子 健太郎, 藤田 静雄
 京都大学大学院工学研究科
- (P12) Si 太陽電池用新規波長変換材料を目指した Tm, Yb 共添加 ZnO の作製と評価◇
 亀井 勇人, 高野 翔太, 吉居 玄哉, 児島 貴徳, 小泉 淳, 藤原 康文
 大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻
- (P13) 単結晶 WO₃ 薄膜を用いたエレクトロクロミック素子の作製と評価◇
 村山 喬之⁽¹⁾, 松尾 昌幸⁽¹⁾, 原田 義之⁽¹⁾, 小池 一歩⁽¹⁾, 佐々 誠彦⁽¹⁾, 矢野 満明⁽¹⁾, 小林 信太郎⁽²⁾, 稲葉 克彦⁽²⁾
⁽¹⁾大阪工業大学ナノ材料マイクロデバイス研究センター, ⁽²⁾株式会社リガク X線研究所
- (P14) α-(Al_xGa_{1-x})₂O₃/ α-Ga₂O₃ のバンドオフセット解析◇
 内田 貴之⁽¹⁾, 神野 莉衣奈⁽¹⁾, 竹本 柊⁽²⁾, 金子 健太郎⁽¹⁾, 藤田 静雄⁽¹⁾
⁽¹⁾京都大学大学院工学研究科, ⁽²⁾京都大学工学部
- (P15) 高品質α-Ga₂O₃に向けた多層α-(Al_xGa_{1-x})₂O₃バッファ層の作製◇
 神野 莉衣奈, 金子 健太郎, 藤田 静雄
 京都大学院工
- (P16) ミスト CVD 法で作製した硫化亜鉛薄膜のフォトルミネセンス特性◇
 浅野 康幸, 宇野 和行, 山崎 佑一郎, 田中 一郎
 和歌山大学システム工学部
- (P17) ミスト CVD 法による Cu₂ZnSnS₄ の成長における塩素の影響○
 池之上 卓己, 渡辺 勇一郎, 三宅 正男, 平藤 哲司
 京都大学エネルギー科学研究科
- (P18) ミストを用いた有機無機ペロブスカイト材料の形成技術○
 西中 浩之, 吉本 昌広
 京都工芸繊維大学電気電子工学系
- (P19) Sn ドープα-Fe₂O₃ 薄膜の電気特性および磁気特性◇
 内田 昌志, 赤岩 和明, 小森 祥央, 掛谷 一弘, 金子 健太郎, 藤田 静雄
 京都大学大学院工学研究科

○：「講演奨励賞」応募講演、◇：「学生優秀講演賞」応募講演

<見学会> 16:30-17:30

福井大学 遠赤外領域開発研究センター

<情報交流会> 18:30-20:30